

5. 低炭素研究ネットワーク 運用方法の件

早稲田大学ナノ理工学研究機構

低炭素ネットワーク支援実施要項

(趣旨)

第1 この要項は、「超低損失電力トランジスタ研究開発拠点」事業の一環として、早稲田大学ナノ理工学研究機構(以下「ナノ機構」という。)における学内外者に対する微細加工・観察計測等の支援実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において「超低損失電力トランジスタ研究開発拠点」とは文部科学省が実施する低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワーク整備事業の一つで、全国の大学、独立行政法人等の研究機関が有する3ハブ拠点・15サテライト拠点の研究施設・機器の共用を進め、低炭素社会構築につながる成果を創出するための事業をいう。

2 この要項において「微細加工・観察計測等の支援」とは、以下の7つの装置による支援(以下「支援」という。)をいう。

- ① 集束イオン/電子ビーム加工観察装置
- ② アトミックレイヤーデポジション (ALD) 装置
- ③ 精密制御半導体基板アライメント・表面処理及び接合システム
- ④ 極微細表面解析装置(顕微ラマン)
- ⑤ 高耐圧デバイス測定装置システム
- ⑥ 表面安定化成膜装置
- ⑦ ラジカルモニター付ダイヤモンド成膜装置

(支援対象者)

第3 支援を受けることができる者は、微細加工・観察計測等に係る研究及び評価その他、ナノ機構長が認める事項を目的とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

- (1) 学術研究機関に所属する研究者等
- (2) 民間企業に所属する研究者等
- (3) その他 ナノ機構長が認めた者

(支援を受けることができる日時)

第4 支援を受けることができる日時は、原則として日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月5日までの日)を除く日の午前10時から午後5時までの間とする。

(支援の申請)

第5 支援を受けようとする者は、原則として支援を受けようとする日の1週間前までに、所定の申請手続を行い、ナノ機構長の承認を得なければならない。

(支援の承認)

第6 ナノ機構長は、第5の申請の内容を確認し、支援を行うことが適当であると認めたときは、これを承認し、支援を行うものとする。

(支援負担金)

第7 支援負担金は、別表のとおりとする。

- 2 支援の承認を得た者は、指定の期日までに支援負担金を納付しなければならない。
- 3 既納の支援負担金は、返還しない。

(消耗品の購入費用)

第8 支援の実施に必要な消耗品の購入費用は、必要に応じて支援を受ける者の負担とする。

(承認の取消し)

第9 支援を受ける者が、この要項に違反したとき又はナノ機構の運営に重大な支障を生じさせたときは、ナノ機構長は、支援の承認を取り消し、支援を停止し、又は事後の支援を承認しないことがある。

- 2 前項に定めるもののほか、早稲田大学(以下「本学」という。)の教育研究上必要があるとき、その他業務上緊急の必要があるときは、ナノ機構長は、支援の承認を取り消すことがある。

(物品の持込み)

第10 支援を受ける者は、物品を研究所に持ち込もうとするときは、あらかじめナノ機構長の許可を得なければならない。

(覚書)

第11 支援を受ける者は、自らの知的財産権の保護のために、知的財産権の扱いと秘密保持に関する覚書をナノ機構長と交わすことができる。

(損害賠償)

第12 支援を受ける者が、故意又は過失により、ナノ機構の施設及び備品等を滅失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに機構長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(適用除外)

第13 本学は、自主事業(非公開により支援を受けることをいう。以下同じ。)を受け入れる場合は、当該自主事業を実施しようとする者と共同研究契約を締結するものとする。この場合において、理事長は、当該自主事業を実施しようとする者に対してこの要項の全部又は一部を適用しないことができる。

(雑則)

第14 この要項に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、ナノ機構長が定める運用要項に従う。

附 則

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7第1項関係)

支援負担金

施設利用料	学内料金	学外料金
クリーンルーム	2,000円/日	5,000円/日
B1共通機器室 006室、007室	500円/日	1,000円/日
2F実験室201	500円/日	1,000円/日
3F実験室303	500円/日	1,000円/日
装置種別	学内単価 (円/hr)	学外単価 (円/hr)
集束イオン/電子ビーム加工観察装置	2,500 円/hr	12,500 円/hr
アトミックレイヤーデポジション (ALD)装置	1,500 円/hr	7,500 円/hr
精密制御半導体基板アライメント装置	1,000 円/hr	5,000 円/hr
ウェハーボンダ	1,000 円/hr	5,000 円/hr
プラズマ活性化装置	500 円/hr	2,500 円/hr
極微細表面解析装置(顕微ラマン)	500 円/hr	2,500 円/hr
高耐圧デバイス測定装置システム	1,500 円/hr	7,500 円/hr
表面安定化成膜装置	3,000 円/hr	15,000 円/hr
ラジカルモニター付きダイヤモンド成膜装置	1,000 円/hr	5,000 円/hr